DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 4 dB

LCATT-DC-30000-A4 — DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 4 dB.

Atenuación: 4 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.4 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.



Características RF

TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	-	0	-	30000	DC–30000	MHz
Atenuación	-	-	-	-	4	dB
VSWR de entrada/salida	-	-	-	-	1.3	-
Planicidad de atenuación	-	-	-	-	±0.4	dB

Valores límite

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Potencia de entrada máxima	-	-	-	30	dBm

Condiciones ambientales

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Temperatura de almacenamiento	-	-65	-	150	°C
Temperatura de funcionamiento	-	-55	-	125	°C

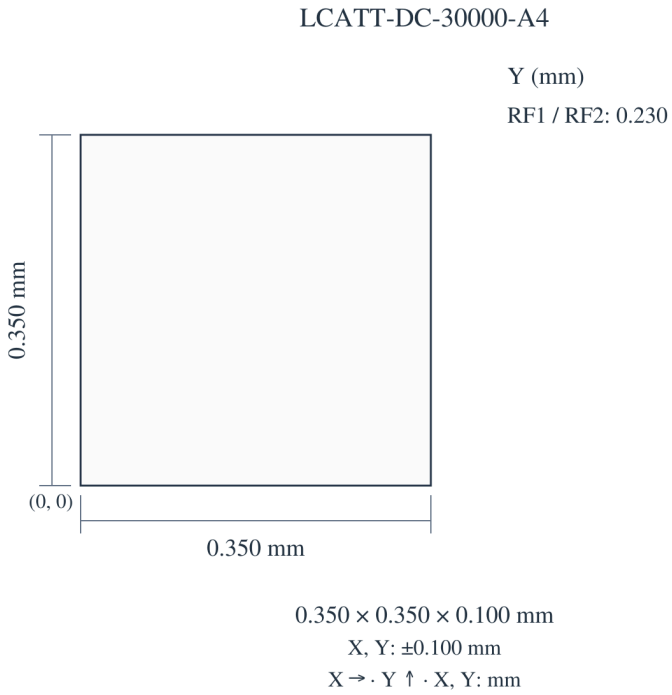
Asignación de pads de unión

Terminales	Símbolo	mm
1	GND	0.100 × 0.050
2	RF1	0.132 × 0.087
3	RF2	0.132 × 0.087
4	GND	0.100 × 0.050

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del chip	0.35 × 0.35 × 0.1	mm

Contorno y coordenadas acotadas en mm. Este plano sirve como referencia dimensional. Para la fabricación y el conexionado por hilo se requieren planos completos.



Registro de la publicación actual · 1.6 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.5.

Integración del chip y secuencia de polarización

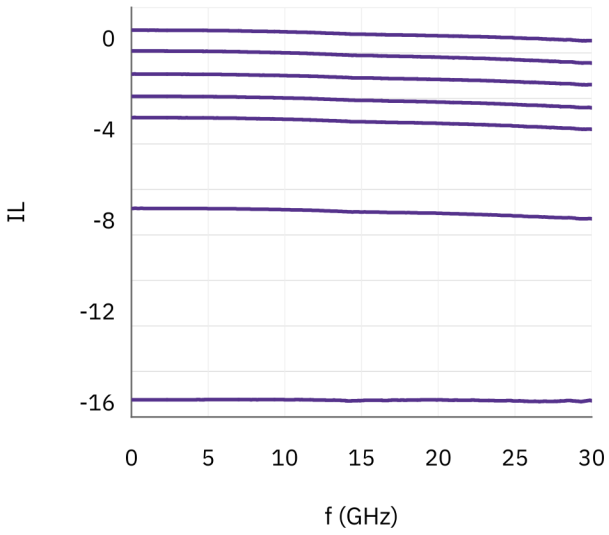
La cara posterior del chip requiere una conexión a tierra fiable.

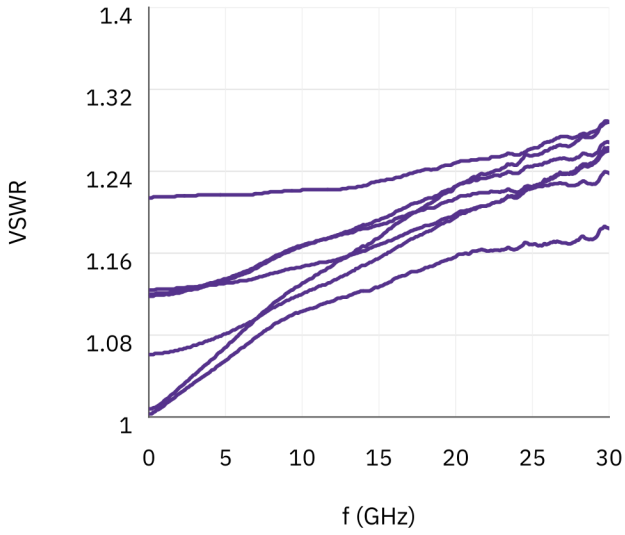
Curvas de rendimiento

Consultar cada figura junto con las condiciones de funcionamiento indicadas.

Curvas de referencia de la serie — Adaptación de puertos; Pérdida de inserción.

Notas de la figura: TA=+25°C. Las lecturas son aproximadas. Estas curvas sirven de referencia común para 7 modelos de la serie. Las trazas no se asignan a modelos concretos. No se especifica la unidad del eje IL.





Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.